

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SD424

○ 電力増幅用

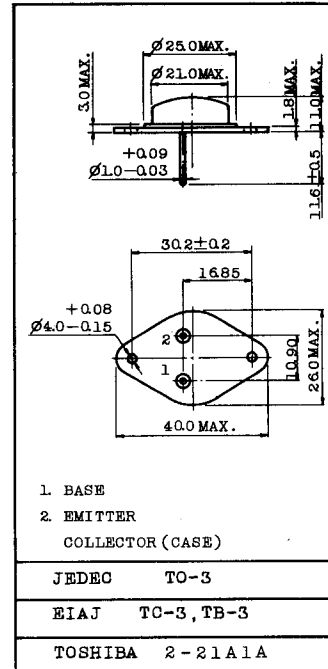
○ Power Amplifier Applications

- ・ コレクタ損失が大きい。 : $P_C = 150W$
- ・ 高耐圧です。 : $V_{CBO} = 180V$
- ・ 2SB554とコンプリメンタリになります。
- ・ 100W Hi-Fi オーディオアンプ出力段に最適です。

Complementary to 2SB554

Recommended for 100 W High-Fidelity Audio
Frequency Amplifier Output Stage.

Unit in mm



最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	15	A
エミッタ電流	I_E	-15	A
コレクタ損失	P_C	150	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$

アクセサリは AC 73 を適用
MOUNTING KIT NO. AC 73

2SD424

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25 °C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=90V, I_E=0$	—	—	100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EB0}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=0.1A, I_B=0$	180	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_E=10mA, I_C=0$	5	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=2A$	40	—	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10A, I_B=1A$	—	—	3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CC}=5V, I_C=10A$	—	—	2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V, I_E=2A$	—	5	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f = 1MHz$	—	300	—	pF

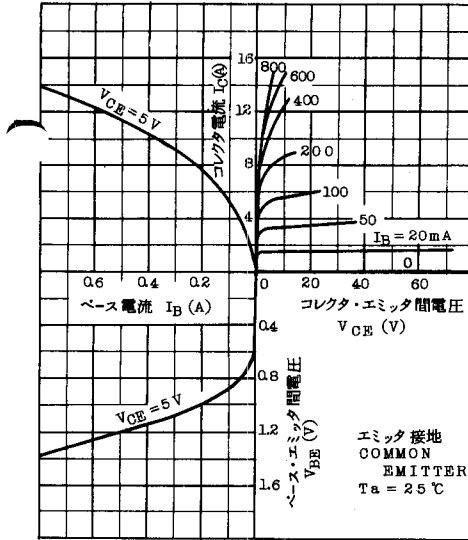
Note ; h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} , the 2SD424 is classified as follows.

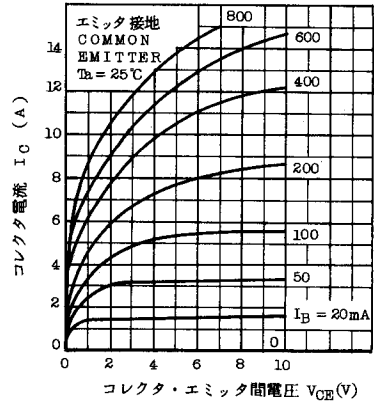
CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SD424-R	40	80
2SD424-O	70	140

2SD424

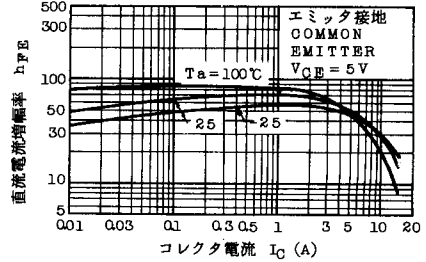
STATIC CHARACTERISTICS



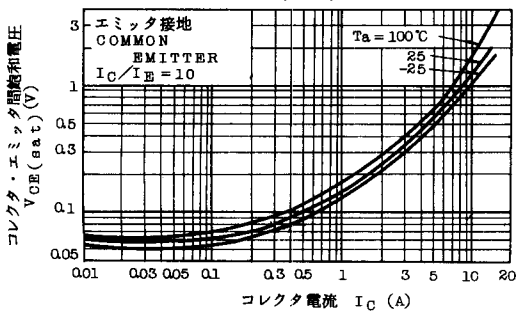
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



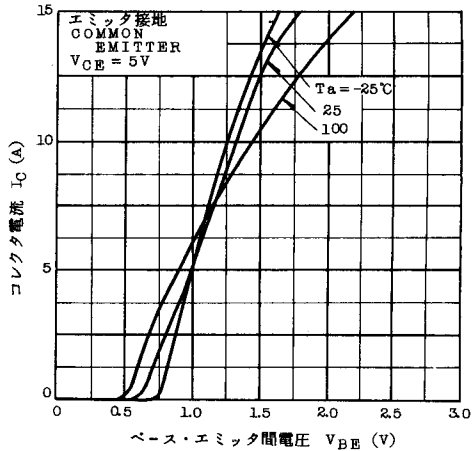
$h_{FE} - I_C$



$V_{CE(sat)} - I_C$

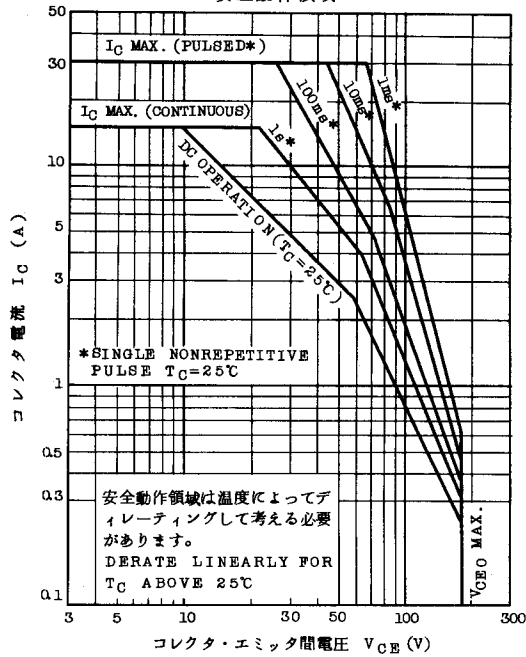


$I_C - V_{BE}$

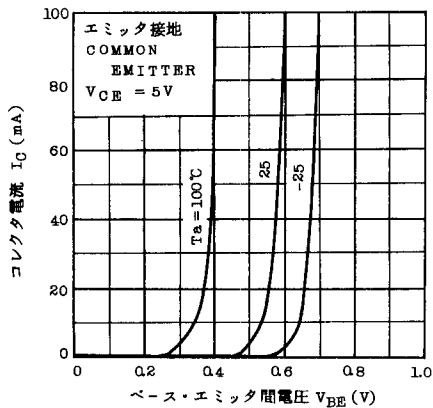


2SD424

安全動作領域 ASO



$I_C - V_{BE}$ (LOW CURRENT REGION)



$P_C - T_C$

